ハイパスフィルタ · 230–2300 MHz

阻止域減衰量 · ≥40 dB (DC–165 MHz). 筐体寸法 (10 ± 0.2) × (7.5 ± 0.2) × (4 ± 0.3) mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	230–2300 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥40 dB
VSWR [1]	≤1.8:1

[1] 230–2300 MHz
[2] DC–165 MHz

設計定格 設計値

項目	値
許容電力	1 W
動作温度	−40...+70 °C
保存温度	−55...+85 °C

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
1	216.06	99.72	-78.19	-78.19	1.44
30	1453.99	3462.89	-49.37	-49.37	1.71
58	1667.7	934.95	-48.18	-48.18	1.4
87	319.88	266.79	-60.34	-60.34	-14.23
115	99.05	115.33	-49.03	-49.03	0.56
144	39.85	50.48	-54.63	-54.63	-14.17
172	17.84	20.3	-43.32	-43.32	-11.11
201	2.09	2.33	-6.21	-6.21	13.56
229	1.25	1.31	-1.68	-1.68	6.77
258	1.11	1.16	-1	-1	3.83
286	1.28	1.28	-0.79	-0.79	2.74
315	1.3	1.3	-0.61	-0.61	1.93
343	1.27	1.26	-0.51	-0.51	1.56

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
372	1.22	1.21	-0.44	-0.44	1.3
400	1.18	1.15	-0.37	-0.37	1.14

機械仕様

項目	値
実装方式	表面実装
品質グレード	産業用
筐体寸法	(10 ±0.2) × (7.5 ±0.2) × (4 ±0.3) mm
パッケージRF端子の内縁間隔	8.8 mm
基板RFランドの内縁間隔	8.6 mm
対向するクリアランスの内縁間隔	7.2 mm
短辺方向のクリアランス開口幅	2.6 mm
パッケージRF端子幅	1.0 mm
基板RFランドの短辺方向幅	1.2 mm
パッケージRF端子の切り欠き径	Ø0.6 mm

実装とプリント基板レイアウト

底面視では、入出力を入れ替えられる2つのRF端子が対向する短辺の中央にあります。底面の斜線部はGNDです。基板中央寄りの各RFランドに50 Ω給電線を配線し、グラウンド銅箔との間隔を確保してください。フットプリントの周囲と下にグラウンドビアを設けてください。 推奨基板レイアウトには、誘電体厚0.254 mmのRO4350Bを使用します。 独立したキャビティへの実装を推奨します。十分な接地を確保するため、可能な限りパッケージの側面、上面および底面をアセンブリの金属筐体に密着させてください。接地が不十分だと阻止域の抑圧が低下します。220 °Cでのリフローはんだ付けに対応します。清掃時はフィルタを洗浄液に浸さず、表面のみを清掃してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。